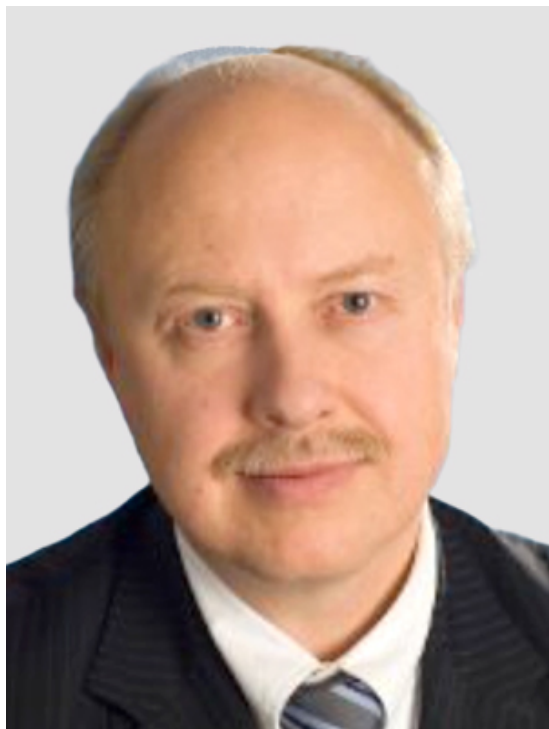


Леденцов Николай Николаевич



член отделения РАН - Отделение физических наук
член секции РАН - Секция общей физики и астрономии
ОНС ЕН

член отделения РАН - Отделение физических наук
член совета - Объединённый научный совет по
естественным наукам (ОНС ЕН)

Звание: профессор

Академическое звание: член-корреспондент РАН

Ученая степень: доктор физико-математических
наук

leden@beam.ioffe.rssi.ru

[+7 \(812\) 297-22-45](tel:+78122972245)

Общая информация

Научные интересы

Физика полупроводников. Физика и технология наноструктур. Эпитаксиальный рост соединений III-V и II-VI

Научные публикации

- Direct formation of vertically coupled quantum dots in Stranski-Krastanow growth NN Ledentsov, VA Shchukin, ME Grundmann, N Kirstaedter, J Böhrer,... Physical Review B 54 (12), 8743
- Quantum dot heterostructures: fabrication, properties, lasers NN Ledentsov, VM Ustinov, VA Shchukin, PS Kop'Ev, ZI Alferov,... Semiconductors 32 (4), 343-365
- Epitaxy of Nanostructures VA Shchukin, NN Ledentsov, D Bimberg Springer
- Quantum Dot Heterostructures D Bimberg, M Grundmann, D, NN Ledentsov Wiley, Chichester
- Low threshold, large T0 injection laser emission from (InGa)As quantum dots N Kirstaedter, NN Ledentsov, M Grundmann, D Bimberg, VM Ustinov,... Electron. Lett 30, 1416
- InAs-InGaAs quantum dot VCSELs on GaAs substrates emitting at 1.3μm JA Lott, NN Ledentsov, VM Ustinov, NA Maleev, AE Zhukov, AR Kovsh,... Electronics Letters 36 (16), 1384-1385
- Ordered arrays of quantum dots: Formation, electronic spectra, relaxation phenomena, lasing NN Ledentsov, M Grundmann, N Kirstaedter, O Schmidt, R Heitz, J Böhrer,... Solid-State Electronics 40 (1-8), 785-798
- Radiative states in type-II GaSb/GaAs quantum wells NN Ledentsov, J Böhrer, M Beer, F Heinrichsdorff, M Grundmann,... Physical Review B 52 (19), 14058
- Quantum-dot heterostructure lasers NN Ledentsov, M Grundmann, F Heinrichsdorff, D Bimberg, VM Ustinov,... IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 6 (3), 439-451
- High performance quantum dot lasers on GaAs substrates operating in 1.5/spl mu/m range NN Ledentsov, AR Kovsh, AE Zhukov, NA Maleev, SS Mikhlin,... Electronics Letters 39 (15),

Премии и награды

- Премия Ленинградского Комсомола в области науки и техники 1986 г
- Медаль «За трудовое отличие» 1986
- Стипендия Премии имени Александра Карпинского Alexander-Petrowitsch-Karpinskij-Preis, Гамбург, ФРГ (1989))
- Премия международного симпозиума по сложным полупроводниковым соединениям, 1986
- Лауреат стипендии фонда Александра фон Гумбольдта 1997
- Орден Дружбы, 1999
- Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники, 2001
- Премия Берлин-Бранденбургской Академии наук, 2002
- Fellow of the Institute of Physics, 2004
- Медаль в ознаменование 300-летия Санкт-Петербурга, 2004

Место работы и должность

главный научный сотрудник, Физико-Технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН

Персональные профили исследователя

Orcid ID 0000-0002-6662-9691